

**IF1322A, IN1322B****N-Channel Matched Dual Silicon Junction Field-Effect Transistor**

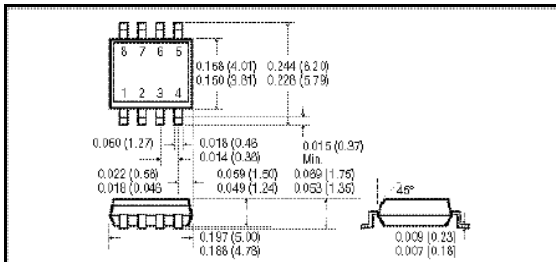
- Low Noise, High Gain Amplifier
- Differential Inputs

**Absolute maximum ratings at  $T_A = 25^\circ\text{C}$** 

Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage	-20V
Continuous Forward Gate Current	10 mA
Continuous Device Power Dissipation	480mW
Power Derating	3.8 mW/ $^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	-65 $^\circ\text{C}$ to +150 $^\circ\text{C}$

At 25 $^\circ\text{C}$ free air temperature Static Electrical Characteristics		IF1322				Process NJ132L	
		Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions	
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS1}$ $V_{(BR)GSS2}$ $V_{(BR)GSS3}$	-20			V	$I_G = -25 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$ $I_G = -3 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$ $I_G = -1 \mu\text{A}, V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Fx	$\frac{V_{(BR)GSS1}}{V_{(BR)GSS2}}$	0.9		1.1			
Gate Reverse Current	$I_{GSS}$			-0.1	nA	$V_{GS} = -10 \text{ V}, V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	-0.8		-1.5	V	$V_{DS} = 10 \text{ V}, I_D = 1 \mu\text{A}$	
Drain Saturation Current (pulsed)	$I_{DSS}$	8		25	mA	$V_{DS} = 10 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	
Gate Source Forward Voltage	$V_{GSF}$	0.3		1.0	V	$V_{DS} = 0 \text{ V}, I_G = -1 \text{ mA}$ $V_{DS} = 0 \text{ V}, I_G = -1 \mu\text{A}$	
Dynamic Electrical Characteristics							
Common-Source Forward Transconductance	$g_{fs}$	0.01			mS	$V_{DS} = 5 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	1 kHz
Differential Gate Source Voltage-	A	$ V_{GS1} - V_{GS2} $		30	mV	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	
	B	$ V_{GS1} - V_{GS2} $		40	mV	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	
Equivalent Short Circuit Input Noise Voltage <sup>1</sup>	$\sim e_N$			4 2	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	100 hz 1 kHz
Equivalent Short Circuit Input Noise Current <sup>1</sup>	$i_n$			0.05	pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 5 \text{ V}, I_D = 3 \text{ mA}$	1 kHz

Note 1: Guaranteed but not tested.



Dimensions in Inches (mm)

**SOIC-8: IF1322**  
1-G1, 2-D1, 3-S1, 4-G2,  
5-G2, 6-D2, 7-S2, 8-G1



715 N. Glenville Dr., Ste. 400  
Richardson, TX 75081  
(972) 238-9700 Fax (972) 238-5338  
[www.interfet.com](http://www.interfet.com)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)